

“GaN 垂直结构三极管加工”次级合同签订说明

本人承担的国家重点研发计划项目《高耐压 GaN 基垂直结构功率器件》在研究过程中需要完成 1500V、5A 的垂直结构三极管，主要工艺过程包括：清洗、光刻、刻蚀、高温退火、激活、金属化、介质生长、膜厚测试、台阶测试等。在研究过程中发现因器件面积较大，且线条宽度需要做到 1 μ m，在北京大学现有工艺线的接触式曝光机上无法实现大面积器件的正常工作，需要使用非接触式光刻和工艺。经了解和沟通，中国科学院微电子研究所具有完善的 2 英寸以及 1/4 英寸 GaN 自支撑衬底上器件加工能力，工艺质量有保证且工艺测试费用报价合理。申请由上述单位为本项目的研究提供加工测试服务，望批准。

项目负责人：王茂俊

签名：

日期：

